

同轴衰减芯片

特点

体积小, 功率容量大, 高频特性好, 性能稳定可靠, 安装方便。应用于微波通信领域、同轴衰减器、卡槽安装的环境中。

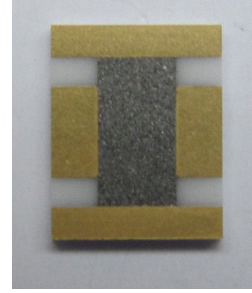
特性参数

外观: 金层表面光洁, 无外来杂质污染, 瓷体表面无裂纹, 无金属毛刺。

焊性: 可金锡合金焊接, 5 秒浸润

膜层耐高温: 400℃, 5 分钟不变色, 不气泡。

平均功率: 2W



衰减值	频率 (GHZ)	衰减精度	回损最小值
10DB	DC-8	0.25DB	22DB
	8-12	0.35DB	20DB
	12-18	0.5DB	17DB

仅正面金属化

金属化结构为 TaN/TiW/Au

TaN: 300-500A

TiW: 300-500A

Au: 2.5uM min

基片材质

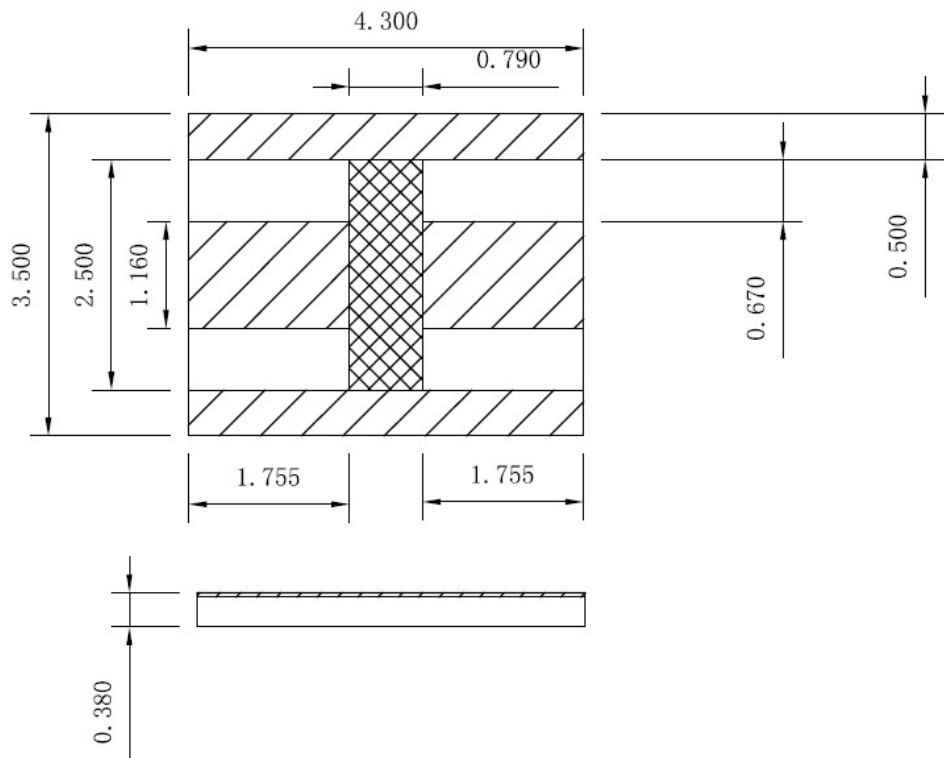
99.6%氧化铝基片, 厚度 0.38mm

尺寸规格

$L=4.3 \pm 0.05\text{mm}$

$W=3.5 \pm 0.05\text{mm}$

$T=0.38 \pm 0.25\text{mm}$



 电极区域

 电阻区域